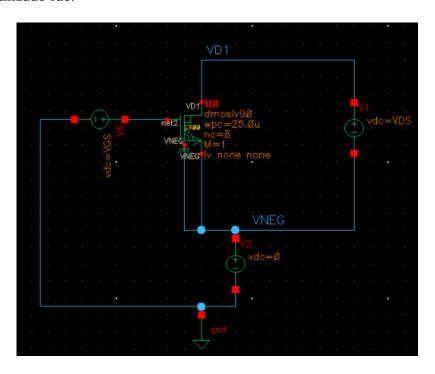
## TP3 - GESTION DE ENERGÍA EN CIRCUITOS INTEGRADOS MAESTRÍA EN CIENCIAS DE LA INGENIERÍA ING. MARIANO MOREL

Para el dmoslv150 obtener mediante simulación los parámetros:

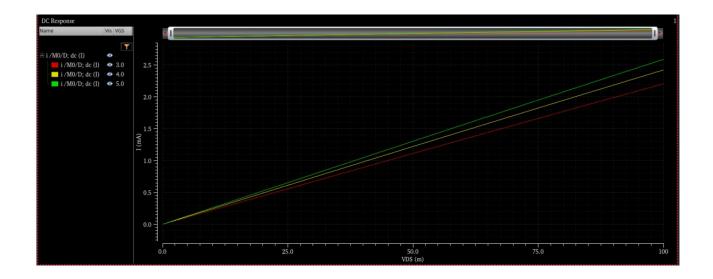
- 1. Rsp y F para  $V_{GS} = \{3,4,5\}V$
- 2. La curva  $V_{GS}$  vs  $Q_g$  para  $V_{DS} = 12$  V. Obtener  $Q_{gd}$ . Indicar los circuitos utilizados para obtener cada parámetro

## **1** - El circuito utilizado fue:



Rdon se obtiene como:

$$R_{
m don} = rac{\Delta V_{DS}}{\Delta I_D}$$



Del gráfico se puede obtener cada R<br/>don dependiendo de cada valor de VGS seteado. Barro con VDS hasta los<br/>  $100 \mathrm{mV}$ 

Rdon(VGS=3V) = 46,52 ohms

Rdon(VGS=4V) = 42,28 ohms

Rdon(VGS=5V) = 39,5 ohms

Para obtener Rsp, hago el producto de Rdon con A, siendo  $A = w \times HP = n \times wf/2 \times 2 \times HP$ .

A (dmos) =  $4 \times 25,47 \times 1,89 \text{ (um)}^2 \text{ (medido del layout del dmos)} = 0,0001924 \text{mm}^2$ 

Por lo tanto Rsp es:

 $Rsp(3V) = 0,00895 \text{ ohms x mm}^2$ 

 $Rsp(4V) = 0.008134672 \text{ ohms x mm}^2$ 

Rsp(5V) = 0.0075998 ohms x mm<sup>2</sup>

Sea F:

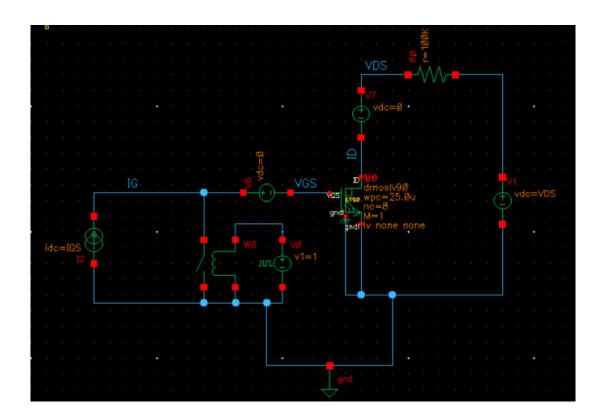
$$F = rac{\Delta I_D}{\Delta V_{GS}}$$

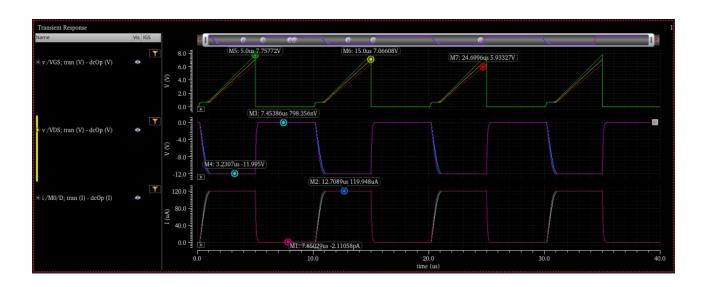
Para los valores de VGS pedidos, obtengo de la simulación (con VGS como variable), los siguientes pares de puntos

(3V,44,7683mA), (4V,53,2797mA), (5V,57,6931mA)

obteniendo mediante un "fiteo", F = 0,0064624 1/ohms

**2** – A continuación se presentan el circuito utilizado y las gráficas de los transitorios de las variables VGS, VDS e ID:





La simulación fue hecha con:

IG={1;1,1:1,2uA}

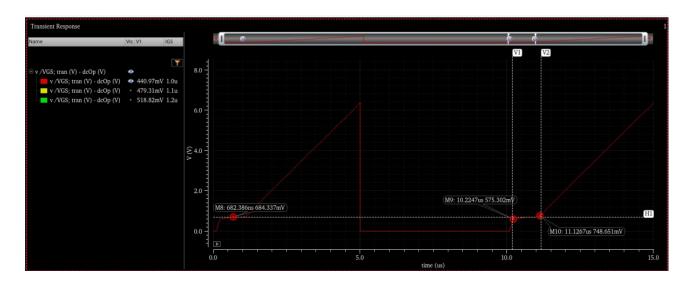
VDS={barrido entre 0 y 12V}

RD=100Kohms

El switch esta controlado con una fuente pulsada de período 10us.

Si bien las gráficas estan en función del tiempo, es claro que si multiplico al tiempo por las corrientes IG, obtengo las gráficas en función de Q, más precisamente VGS vs Qg, que es una versión escalada de la gráfica de VGS vs t.

Para obtener Qgd, utilizo el siguiente gráfico.



Tal como se ve en la gráfica (lo hago solo para una IG), Qgd se obtiene a la tensión de aproximadamente 684,337mV, haciendo la diferencia (escalada en este caso por 1uA) de 11,1267us y 10,2247us, se obtiene Qgd= 0,902pC